## Si(110)基板上 3C-SiC(111)回転エピ膜上に形成したエピタキシャル グラフェンの断面 TEM 評価

Cross-sectional TEM Observation of Epitaxial Graphene formed on Rotated-Epi-Film of 3C-SiC(111) on Si(110) Substrates

東北大通研<sup>1</sup>, トモスク州立大学<sup>2</sup>, 東北大金研<sup>3</sup>, JST/CREST<sup>4</sup>, <sup>0</sup>三本菅 正太<sup>1</sup>, 長澤 弘幸<sup>1</sup>, Sergey Filimonov<sup>2</sup>, 伊藤 駿<sup>3</sup>, 吹留 博一<sup>1</sup>, 末光 眞希 <sup>1,4</sup>

RIEC, Tohoku Univ. <sup>1</sup>, Dept. of Physics, Tomsk State Univ. <sup>2</sup>, IMR, Tohoku Univ. <sup>3</sup>, JST/CREST<sup>4</sup>, Shota Sambonsuge<sup>1</sup>, Hiroyuki Nagasawa<sup>1</sup>, Sergey Filimonov<sup>2</sup>, Shun Ito<sup>3</sup>, Hirokazu Fukidome<sup>1</sup>, Maki Suemitsu<sup>1, 4</sup>

E-mail: shota-04@riec.tohou.ac.jp

Si 基板上へテロエピ SiC 薄膜の熱改質によりグラフェンを成膜するグラフェン・オン・シリコ ン(GOS)プロセスは、Si テクノロジーにグラフェンを導入する際の一つの有力技術として注目さ れている [1-3]。GOS 膜の品質は未だ SiC バルク結晶上のエピタキシャルグラフェンに劣るが、 その原因のひとつは Si と SiC との格子不整合(約20%)に起因する面欠陥の多さである。格子不 整合を解消する対策の一つは、Si(110)上への 3C-SiC(111)回転エピタキシャル成長である[4-6]。 Fukidome ら[7]はこの 3C-SiC(111)/Si(110)表面へのグラフェン形成に成功し、かつそのグラフェン が 6H-SiC(000-1)C 面上グラフェンと同様の形成過程と積層構造であることを報告している。回転 エピ膜上に形成したグラフェンは、3C-SiC(111)/Si(111)エピ膜上のそれに比べ膜質が向上すること は、そのラマン散乱スペクトル強度比(I<sub>G</sub>/I<sub>D</sub>比)が 1.3 倍になることから確認されている。そして、 それは回転エピ SiC 薄膜の高品質化がもたらしたと理解されている[8]。これを確認するため、我々 は、回転エピ膜及びそれを用いた GOS の断面構造を透過電子顕微鏡で観測し、3C-SiC 薄膜中の 欠陥を同定するとともに、その発生原因を考察した。

図 1 は 3C-SiC(111)/Si(110)の断面 TEM 像である。SiC 中にはその整合界面を異なる方位に配向 させた stacking faults(SF: 赤線)と double positioning boundary(DPB: 黄色線)が見いだされる。DPB は 3C-SiC(111)/Si(111)エピ膜上には存在せず[9]、C 面(111)成長を示す回転エピ膜に特有のもので

ある。発表では、SFや DPB の発生機構、なら びにそれらがグラフェン中に誘起する欠陥と の関係を考察する。

- [1] M. Suemitsu et al., e-J. Surf. Sci. Nanotech, 7, 311 (2009).
- [2] Y. Miyamoto et al., e-J. Surf. Sci Nanotech. 7, 107 (2009).
- [3] H. Fukidome et al., J. Mater. Chem. 21, 17242 (2011).
- [4] T. Nishiguchi *et al.*, Appl. Phys. Lett. **84**, 3082 (2004). [5] A. Konno *et al.*, ECS Transactions **3**, 449 (2006).
- [6] R. Anzalone et al., J. Appl. Phys. 105 084910 (2009).
- [7] H. Fukidome et al., Appl. Phys. Exp. 4, 115104 (2011).
- [8] S. Sambonsuge et al., The 73th JASP Autumn Meeting (2012).
- [9] H. Handa et al., Jpn. J. Appl. Phys. 50, 04DH02 (2011).

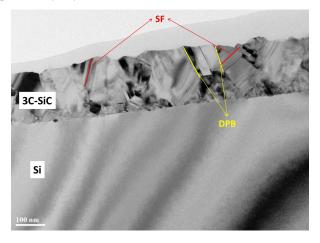


Fig. 1 SiC(111)/Si(110)の断面 TEM 像(明視野)